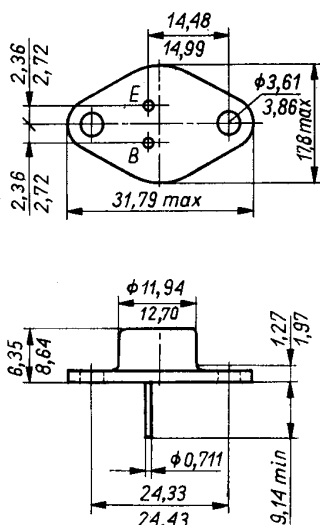


Tranzystory germanowe stopowe średniej mocy małej częstotliwości. Są przeznaczone do stosowania we wzmacniaczach akustycznych średniej mocy. Do układów przeciwnobnych tranzystory są dobierane parami.

sl 74



Tranzystor w obudowie metalowej TO66(CE24). Kolektor jest połączony z obudową.

DANE TECHNICZNE

Wartości dopuszczalne parametrów eksploatacyjnych

Typ		ADP665	ADP666	
Napięcie kolektor-baza	$-U_{CB0}$	30	60	V
Napięcie kolektor-emiter	$-U_{CES}$	30	60	V
Napięcie kolektor-emiter	$-U_{CE0}$	15	30	V
Napięcie emiter-baza	$-U_{EB0}$	10	10	V
Prąd kolektora	$-I_C$	1,5	1,5	A
Prąd emitera	I_E	1,5	1,5	A
Prąd bazy	$-I_B$	0,25	0,25	A
Temperatura złącza	t_j	348 K (75°C)		
Zakres temperatury składowania	t_{stg}	218...348 K (-55...+75°C)		
Moc strat kolektora przy $t_{case} = 298$ K (+25°C)	P_C	5	5	W

2 Elementy półprzewodnikowe

SWW 1156-221

Parametry termiczne

Rezystancja termiczna

złącze-otoczenie	$R_{th(j-a)}$	≤ 66	≤ 66 K/W
złącze-obudowa	$R_{th(j-c)}$	≤ 10	≤ 10 K/W

TRANZYSTOR ADP665

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)

min. typ. maks.

Współczynnik wzmocnienia prądowego

przy $-I_C = 0,1$ A,

$-U_{CE} = 6$ V

h_{21E}

20 — 120 —

przy $-I_C = 1$ A,

$-U_{CE} = 1$ V

h_{21E}

12 — — —

Prąd zerowy kolektora

przy $-U_{CB} = 12$ V $-I_{CB0}$

— 10 50 μ A

przy $-U_{CB} = 12$ V,

$t_{amb} = 343$ K (70°C) $-I_{CB0}$

— 260 500 μ A

Prąd zerowy emitera

przy $-U_{EB} = 6$ V $-I_{EB0}$

— 8 50 μ A

Napięcie przebicia kolektor-baza

przy $-I_C = 200$ μ A,

$I_E = 0$

$-U_{(BR)CB0}$

30 — — V

Napięcie przebicia kolektor-emiter

przy $-I_C = 200$ μ A,

$R_{BE} = 0$

$-U_{(BR)CES}$

30 — — V

przy $-I_C = 0,2$ A,

$-I_B = 0$

$-U_{(BR)CE0}$

15 — — V

Napięcie przebicia emiter-baza

przy $-I_E = 100$ μ A,

$-I_C = 0$

$-U_{(BR)EB0}$

10 — — V

Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298$ K (25°C)

min. typ. maks.

Częstotliwość graniczna

przy $-U_{CB} = 6$ V,

$-I_C = 0,1$ A,

$f = 100$ kHz

f_T

0,1 0,38 — MHz

Stosunek współczyn-
ników wzmacnienia
prądowego dobra-
nych par *

przy $-U_{CE} = 6 \text{ V}$, $-I_C = 0,1 \text{ A}$	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3	—
przy $-U_{CE} = 1 \text{ V}$, $-I_C = 1 \text{ A}$	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3	—

TRANZYSTOR ADP666

Parametry statyczne

przy $t_{amb} = 298 \text{ K}$ (25°C)		min.	typ.	maks.	
Współczynnik wzmacnienia prą- dowego					
przy $-I_C = 0,1 \text{ A}$, $-U_{CE} = 6 \text{ V}$	h_{21E}	20	—	120	—
przy $-I_C = 1 \text{ A}$, $-U_{CE} = 1 \text{ V}$	h_{21E}	12	—	—	—
Prąd zerowy kolek- tora					
przy $-U_{CB} = 12 \text{ V}$ $-I_{CB0}$		—	10	50	μA
przy $-U_{CB} = 12 \text{ V}$, $t_{amb} = 343 \text{ K}$ (70°C) $-I_{CB0}$		—	260	500	μA
Prąd zerowy emitera					
przy $-U_{EB} = 6 \text{ V}$ $-I_{EB0}$		—	10	50	μA
Napięcie przebicia kolektor-baza					
przy $-I_C = 200 \mu\text{A}$, $-I_E = 0$	$-U_{(BR)CB0}$	60	—	—	V

Napięcie przebicia
kolektor-emiter

przy $-I_C = 200 \mu\text{A}$, $R_{BE} = 0$	$-U_{(BR)CES}$	60	—	—	V
przy $-I_C = 0,2 \text{ A}$, $-I_E = 0$	$-U_{(BR)CE0}$	30	—	—	V

Napięcie przebicia
emiter-baza

przy $-I_E = 100 \mu\text{A}$, $-I_C = 0$	$-U_{(BR)EB0}$	10	—	—	V
---	----------------	----	---	---	---

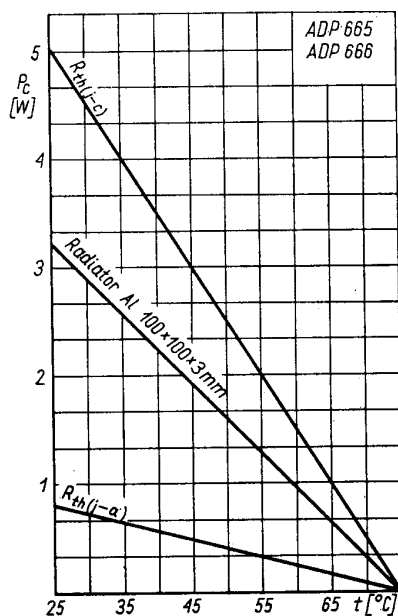
Parametry dynamiczne

przy $t_{amb} = 298 \text{ K}$ (25°C)		min.	typ.	maks.	
Częstotliwość gra- niczna					
przy $-U_{CB} = 6 \text{ V}$, $-I_C = 0,1 \text{ A}$, $f = 100 \text{ kHz}$	f_T	0,1	0,38	—	MHz

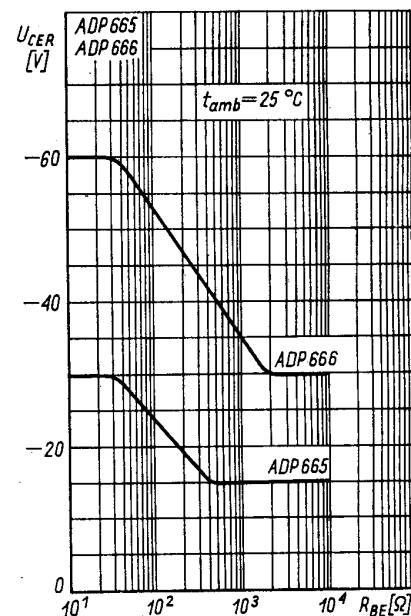
Stosunek współczyn-
ników wzmacnie-
nia prądowego do-
branych par *

przy $-U_{CE} = 6 \text{ V}$, $-I_C = 0,1 \text{ A}$	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3	—
przy $-U_{CE} = 1 \text{ V}$, $-I_C = 1 \text{ A}$	$\frac{h_{21E(1)}}{h_{21E(2)}}$	—	—	1,3	—

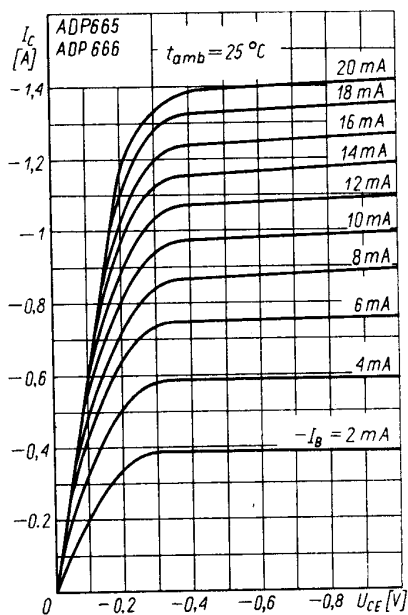
* Tranzystory dobiera się w pary na życzenie odbiorcy określo-
ne w zamówieniu.



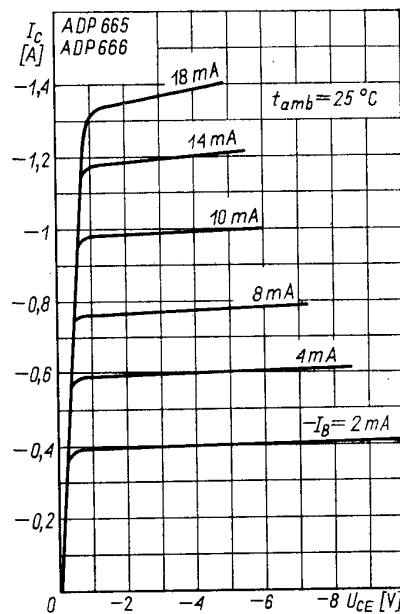
Zależność temperaturowa mocy strat $P_C = f(t)$



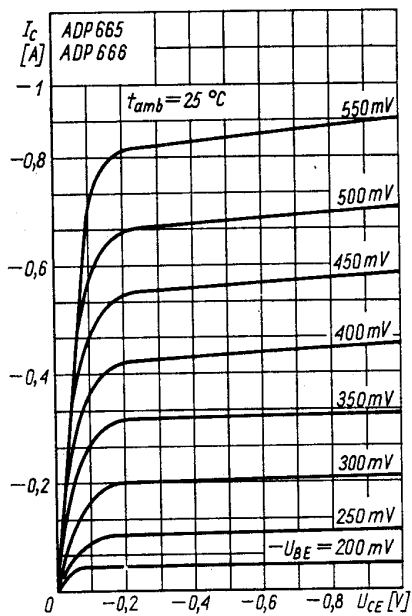
Zależność napięcia kolektor-emiter od rezystancji
baza-emiter $U_{CER} = f(R_{BE})$



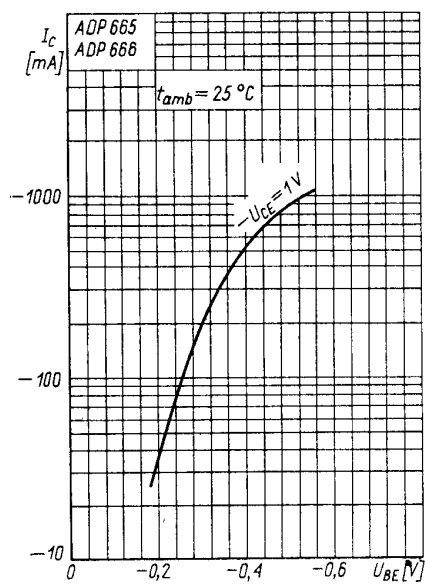
Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE})$; I_B — parametr



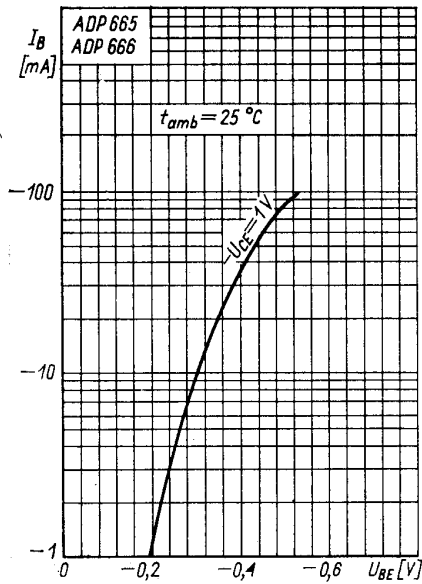
Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE})$; I_B — parametr



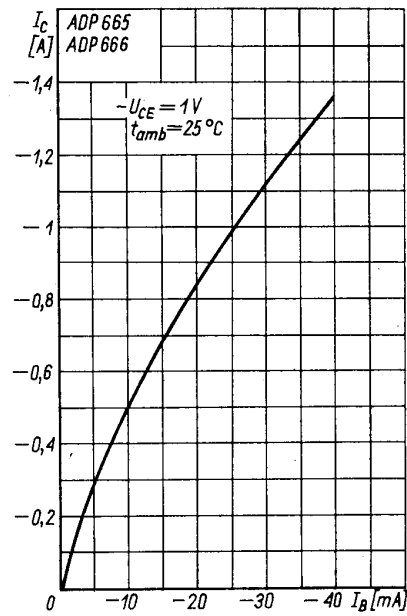
Charakterystyka wyjściowa $I_C = f(U_{CE})$; U_{BE} — parametr



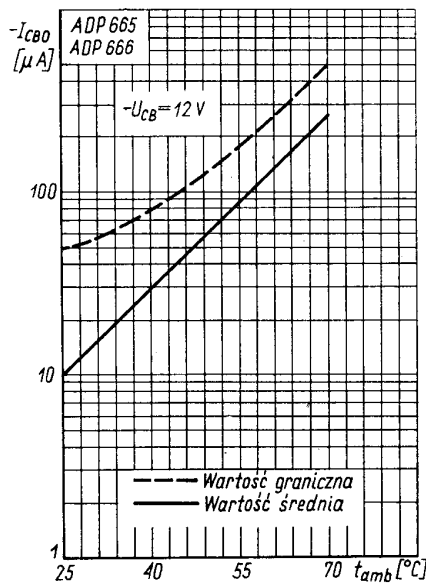
Zależność prądu kolektora $I_C = f(U_{BE})$



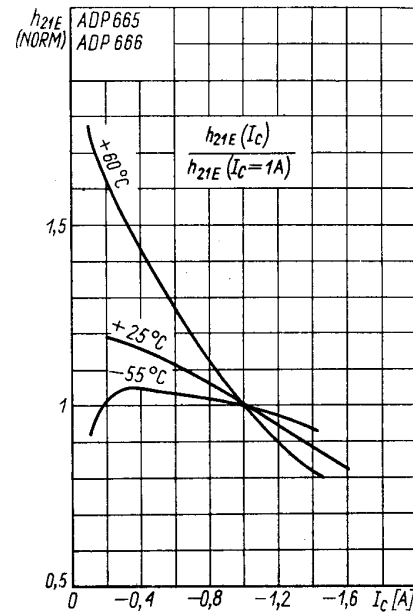
Charakterystyka wejściowa $I_B = f(U_{BE})$; U_{CE} — parametr



Charakterystyka przejściowa $I_C = f(I_B)$



Zależność temperaturowa prądu zerowego $I_{CB0} = f(t_{amb})$



Zależność statycznego współczynnika wzmocnienia prądowego znormalizowanego od prądu kolektora $h_{21E(n)} = f(I_C)$

PRODUCENT



NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
PÓŁPRZEWODNIKÓW „TEWA”
ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 431431
Teleks: 813219

DYSTRYBUTOR



BIURO ZBYTU SPRZĘTU
TELERRADIOTECHNICZNEGO
ul. Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813435

This datasheet has been download from:

www.datasheetcatalog.com

Datasheets for electronics components.